



АНДРІЄВСЬКИЙ Володимир Васильович (17. 10. 1944, м. Краснодар, РФ) — фізик. Доктор фізико-математичних наук (2005). Закінчив Харківський університет (1967). Від 1968 працює у Фізико-технічному інституті низьких температур НАНУ (Харків): від 2002 — провідний науковий співробітник, заступник завідувача відділу транспортних властивостей провідних і надпровідних систем, від 2021 — провідний

науковий співробітник, заступник завідувача відділу мікроконтактної спектроскопії. Досліджує електронні кінетичні явища у тонких плівках, провідних системах з обмеженою геометрією, неупорядкованих і низьковимірних провідниках.

Основні праці

On the Magnetoresistance Maximum Observed in the Intermediate Magnetic Field Region for the TwoDimensional Hole Gas in a Strained $\text{Si}_{0,05}\text{Ge}_{0,95}$ Quantum Well // J. of Low Temperature Physics. 2012. Vol. 168, № 5—6; The 2D conducting system formed by nanocrystallites CrSi_2 in the (111) plane of silicon: New object // Elsevier, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2014. Vol. 64; Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures // Elsevier, Physica status solidi (b). 2015. Vol.252; The overheating effects in germanium quantum well with two subbands occupied // Low Temperature Physics. 2018. Vol. 44, № 8; Quantum effects in silicon-germanium p-type heterostructures with quantum wells of different widths // Там само. 2023. Vol. 49, № 1 (усі — співавт.).

Ю. О. Колесниченко, А. В. Терехов

Бібліографічний опис:

Андрієвський Володимир Васильович / Ю. О. Колесниченко, А. В. Терехов // *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2025. — Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-891411>

2001-2025 © Ця енциклопедична стаття захищена авторським правом згідно з чинним законодавством України ([докладніше](#)).